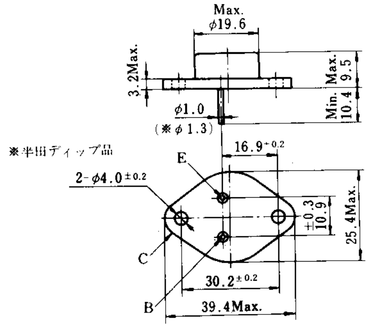
# 2SA1116

■シリコンPNPエピタキシャルプレーナ形トランジスタ

○一般用

☆2SC2607とコンプリメンタリペアになります。

外形寸法(単位：mm)
JEDEC(TO-3), EIAJ(TC-3, TB-3)




## ■最大定格 (Ta＝25℃)

| 項　　目 | 記　号 | 2SA1116 |
|---|---|---|
| コレクタ・ベース電圧 | $V_{CBO}$ | −200 V |
| コレクタ・エミッタ電圧 | $V_{CEO}$ | −200 V |
| エミッタ・ベース電圧 | $V_{EBO}$ | −6 V |
| コレクタ電流 | $I_C$ | −15 A |
| ベース電流 | $I_B$ | −5 A |
| 許容コレクタ損失 | $P_C$ | 150 W(フランジ温度25℃) |
| 接合部温度 | $T_j$ | 150 ℃ |
| 保存温度 | $T_{stg}$ | −65 ～ +150℃ |

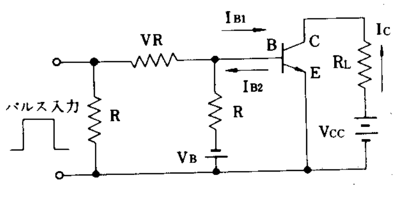
## ■電気的特性 (Ta＝25℃)

| 項　　目 | 記　号 | 試 験 条 件 | 2SA1116 |
|---|---|---|---|
| 最大コレクタしゃ断電流 | $I_{CBO}$ | $V_{CB}$ = −200V | −100 μA |
| 最大エミッタしゃ断電流 | $I_{EBO}$ | $V_{EB}$ = −6V | −100 μA |
| コレクタ・エミッタ電圧 | $V_{CEO}$ | $I_C$ = −50mA | −200 V |
| 直流電流増幅率 | $h_{FE}$ | $V_{CE}$ = −4V<br>$I_C$ = −5A | 30 Min. |
| コレクタ飽和電圧 | $V_{CE(sat)}$ | $I_C$ = −10A<br>$I_B$ = −1A | −3.0V Max. |
| しゃ断周波数 | $f_T$ | $V_{CE}$ = −12V<br>$I_E$ = 0.5A | 20 MHz Typ. |

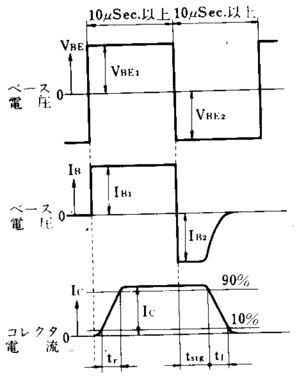
## ■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

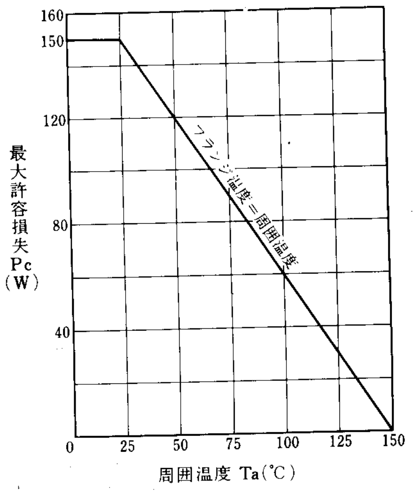
| $V_{CC}$ (V) | $R_L$ (Ω) | $I_C$ (A) | $I_{B1}$ (mA) | $I_{B2}$ (mA) | $t_r$ (μSec.) | $t_{stg}$ (μSec.) | $t_f$ (μSec.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −60 | 12 | −5 | −500 | 500 | 0.3 | 0.9 | 0.2 |

### スイッチング特性測定回路




### 測定条件




### 周囲温度と最大許容損失